











3. Methoden der Oberflächenphysik

. . . .

Übersicht über Kapitel 3

- 3. Methoden der Oberflächenphysik
- 3.1 Kristallpräparation
- 3.2 Chemische Oberflächenanalyse
- 3.3 Beugungsmethoden
- 3.4 Frühe Realraumabbildung
- 3.5 Transmissionselektronenmikroskopie
- 3.6 Rasterelektronenmikroskopie
- 3.7 Rastertunnelmikroskopie
- 3.8 Rasterkraftmikroskopie



Lernziele

- Vertraut werden mit früheren Methoden zu Abbildungen im Realraum
- Verständnis zum Aufbau eines Rastertunnelmikroskops
- Tunnel-Theorie



Die de Broglie Wellenlänge











6

3.3 Beugungsmethoden





Review von Vorlesung 2 und 3

Überstrukturen im reziproken Raum



Fig.1.7. Diffraction pattern of two domains of a (1×2) superlattice and a $c(2\times 2)$ superlattice on a (100) surface of a cubic material.

Low Energy Electron Diffraction (LEED) pattern einer Si(100) Oberfläche



Stufen auf Si(100)







Khalil Zakeri-Lori und Philip Willke, Vorlesung "Oberflächenphysik"

SS 2022 8

Ibach, S. 38

3.3 Beugungsmethoden



Cu(001) E= 78 eV



SPA LEED (Spot Profile Analysis)
Man erhält Informationen
über die genaue
Beschaffenheit der Oberfläche



Cu(1,1,13)





Khalil Zakeri-Lori und Philip Willke, Vorlesung "Oberflächenphysik" <u>https://www.researchgate.net/publication/306284856_The_role_of_electron_confinement_in_Pd_film</u> <u>s_for_the_oscillatory_magnetic_anisotropy_in_an_adjacent_Co_layer/figures?lo=1</u>

3.3 Beugungsmethoden

Dynamic scattering theory

- Durch Berücksichtigung aller Streumöglichkeiten und der korrekten Geometrie, kann die Profilintensität von LEED-IV quantitativ vorausgesagt werden
- Vielfachstreuung und die Abnahme der Amplitude beim Durchgang in tiefere Schichten.





Abb. 3.7.4

Intensität eines Reflexes als Funktionder Beschleunigungsspannung V (schematisch) a) Einfachstes kinematisches Modell

b) Einfachste Berücksichtigung der Vielfach-Streuung (verbotene Zonen)

c) Berücksichtigung von Dämpfung

d) Berücksichtigung von innerem Potential und Phasenverschiebung

e) Berücksichtigung aller Vielfachstreuungen

Abb. 3.7.3 Streuprozesse für die Intensitätsberechnung

- a) Einfachstreuung
- b) Zweifachstreuung in einer Schicht
- c) Mehrfachstreuung



Khalil Zakeri-Lori und Philip Willke, Vorlesung "Oberflächenphysik"

SS 2022 10 Reflection High Energy Electron Diffraction (RHEED)



• Kleine Impulsänderung q trotz hoher Elektronenenergie durch flachen Einfall



3.3 Beugungsmethoden

RHEED-Beugungsbilder von GaAs(110)- Flächen





Khalil Zakeri-Lori und Philip Willke, Vorlesung "Oberflächenphysik"

SS 2022 Henzler, S. 138 + 175¹²

Reflection High Energy Electron Diffraction (RHEED)





https://en.wikipedia.org/wiki/Reflection highenergy electron diffraction





Heliumstreuung (TEAS)



Heliumstreuung (TEAS)

Thermal Energy Atom Scattering (TEAS)



- Hauptsächlich mit den Atomen H, He, Ne und den Molekülen H₂, HD und D₂ durchgeführt.
- kleineren Masse → stärkere Streuung und wenig reaktiv

- He-Atom-Strahl: ΔE/E~2%
- Einfallsenergie: 10-60meV
- elastische und inelastische (time-of-flight) Messungen möglich



3.4 Frühe Abbildungstechniken im Realraum

Feldemissionsmikroskopie (FEM) und Feldionenmikroskopie (FIM)





Fig. 7.2. Field emission microscopy pattern of a clean (110) oriented tungsten surface, showing the location of various crystal planes (after Müller [7.1])

- Scharfe Nadel mit mittlerem Radius von 10 100 nm
- Elektrisches Feld (U = 1-10 keV)
- Felderhöhung an der Spitze





Feldemissionsmikroskopie (FEM) und Feldionenmikroskopie (FIM)



- Ähnlich wie FEM, aber unter Anwesenheit eines "Imaging Gas" (z.B. He oder Ne bei 10⁻² Pa)
- Spitzenpotential ist jetzt positiv
- Auflösung bis etwa 1-3 Å (atomare Auflösung)
- Polarisierung der He Atome durch das Starke Feld



Fig. 7.4. FIM image of a W tip of radius ${\sim}120\,\text{\AA}$ acquired at 21 K using a He-H_2 mixture as the imaging gas (after Tsong and Sweeney [7.3])



3.4 Frühe Abbildungstechniken im Realraum

Feldionenmikroskopie (FIM)



FIM-Aufnahme einer W-Spitze (helle Punkte entsprechen Atomen)



3.5 Transmissionselektronenmikroskop

Electron gun

Condenser aperture

Condenser lens

Sample

Screen

Objective lens

Objective aperture

TEM



Funktionsweise analog zu optischem

Mikroskop (jedoch magnetische Linsen)

> Beugungslimit: 0,5 λ / sin $\alpha \approx$ 2 Å (idealisiert)

Nicht anwendbar bei dicken Proben







https://www.youtube.com/watch?v=fQJYuTpK8Fs



3.6 Rasterelektronenmikroskop



- Elektronenstrahl (1-10 keV) fokussiert auf Probe (Durchmesser 10-100 Å)
- Rastern des Strahls
- Nachweis von zurückgestreuten Elektronen, Auger-Elektronen (elementspezifisch), oder Fluoreszenz-Röntgenphotonen

Abbildung auf Bildschirm





Khalil Zakeri-Lori und Philip Willke, Vorlesung "Oberflächenphysik"

SS 2022 22

Oura, S. 157







https://en.wikipedia.org/wiki/Scanning_electron_microscope





https://www.youtube.com/watch?v=uQ1gClkCblQ



3.7 Rastertunnelmikroskopie

Der "Topografiner": Ein Instrument zur Messung der Mikrotopographie einer Oberfläche





Fig. 4. Topographic map of ruled diffraction grating with the Topografiner. Labeled distances are in angströms. 1 Å = 0.1 nm. (From Ref. [1]).



Russell Young, John Ward, und Fredric Scire



Erfindung der Rastertunnelmikroskopie Nobel Preis für Physik 1986



Heinrich Rohrer und Gerd Binnig

- atomare Auflösung in z-Richtung
- laterale atomare Auflösung

atomare Stufen auf Au(110)





Erfindung der Rastertunnelmikroskopie Nobel Preis für Physik 1986



Heinrich Rohrer und Gerd Binnig

 atomare Auflösung in x,y und z-Richtung

Si111 7x7



2 Stunden nach der Nobelpreis-Ankündigung



Binnig, Rohrer et al. Phys. Rev. Lett. 50(2) 1983

3.7 Rastertunnelmikroskopie

Prinzip

- Misst atomare und elektronische Struktur der Probe (und der Spitze...)
- Spitze wird in die N\u00e4he der Oberfl\u00e4che einer zu untersuchenden Probe gebracht und "gerastert"
- Die Wechselwirkung zwischen Probe und Spitze wird mit Hilfe eines Regelkreises konstant gehalten (Tunnelstrom oder Kraft)
- Ein RTM (STM) misst den quantenmechanischen Tunnelstrom





3.7 Rastertunnelmikroskopie

Zutaten

- Spitze: Spitzen aus Wolfram oder einer Platin-Iridium-Legierung geformt durch elektrochemischen Ätzprozess oder auch nur durch einfaches Zerreißen oder Schneiden des Drahtes geformt
- IU-Konverter: Messung des Tunnelstroms: Tunnelstrom ~10 pA bis 1 µA kann durch einen Operationsverstärkerschaltungen in eine Spannung verwandelt werden.
- **Tunnelspannung**: liegt im Bereich von wenigen Millivolt bis einigen Volt und kann über einen Digital-Analog-Wandler vom PC realisiert werden.



Scharfe und regelmäßige Spitzen durch Ätzen eines W Drahts Verstärker der Fa. Femto

VARIABLE GAIN LOW NOISE CURRENT AMPLIFIER DLPCA-200



Products | Current Amplifiers | Variable Gain up to 500 kHz - DLPCA

https://www.femto.de/en/products/currentamplifiers/variable-gain-up-to-500-khz-dlpca.html



Literatur

STM Ibach S. 55 Henzler S. 114 - 116 Fauster S. 127 – 134 Chen: Introduction to Scanning Tunneling Microscopy

ausgiebige Webseite zu STM der FAU Erlangen <u>https://www.archive.fkp.physik.nat.fau.eu/methoden/stmtutor/stmpage.html</u>

Tunneleffekt: <u>https://www.youtube.com/watch?v=K64Tv2mK5h4</u>

Typ, der sein eigenes STM Zuhause gebaut hat https://dberard.com/

Videos über das Nanocar Race https://av.tib.eu/media/50309

